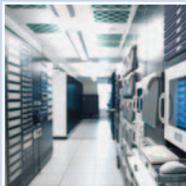




## 650V CoolMOS™ CFD2

Neue marktführende 650V CoolMOS™ CFD2 Technologie mit integrierter Fast-Body-Diode eingeführt



Mit der neuen 650V CoolMOS™ CFD2 Technologie bringt Infineon die zweite Generation der führenden Hochvolt-CoolMOS™-MOSFETs mit integrierter Fast-Body-Diode auf den Markt. Dieses herausragende Produkt mit verbesserter Energieeffizienz soll der Nachfolger des 600V CFD sein. Die bessere Kommutierungseigenschaft und das optimierte EMI-Verhalten sind klare Wettbewerbsvorteile.

### Vorteile des Infineon 650V CoolMOS™ CFD2

- Erste 650V Technologie mit integrierter Fast-Body-Diode am Markt
- Limitierte Spannungsüberschreitung während harter Kommutierung
- Signifikante  $Q_g$  Reduktion im Vergleich zu auf C3 basierender CFD Technologie
- Optimiert für einfaches Design-in
- Geringere Streuung des  $R_{dson}$
- Preisvorteil gegenüber CFD Technologie basierend auf C3

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite:

[ [www.infineon.com/cfd2](http://www.infineon.com/cfd2) ]

[www.BDTIC.com/infineon](http://www.BDTIC.com/infineon)